

长江证券承销保荐有限公司  
关于江苏吉莱微电子股份有限公司  
首次公开发行股票并在创业板上市  
之  
上市保荐书



中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层

二零二二年六月

## 声 明

本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（下称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（以下简称“《注册管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）、深圳证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《江苏吉莱微电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中相同的含义。

## 目 录

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| 一、发行人概况 .....                       | 3  |
| 二、本次发行概况 .....                      | 18 |
| 三、本次证券发行的保荐机构工作人员情况 .....           | 19 |
| 四、保荐机构是否存在可能影响其公正履行保荐职责的情形的说明 ..... | 20 |
| 五、保荐机构按照有关规定应当承诺的事项 .....           | 20 |
| 六、本次证券发行上市所履行的决策程序 .....            | 22 |
| 七、保荐机构关于发行人本次证券发行符合上市条件的说明 .....    | 23 |
| 八、保荐机构对发行人持续督导工作的安排 .....           | 23 |
| 九、保荐机构和保荐代表人联系方式 .....              | 25 |
| 十、保荐机构认为应当说明的其他事项 .....             | 25 |
| 十一、保荐机构对本次股票上市的推荐结论 .....           | 25 |

## 一、发行人概况

### （一）发行人的基本情况

|                |                                        |
|----------------|----------------------------------------|
| 中文名称           | 江苏吉莱微电子股份有限公司                          |
| 英文名称           | Jiangsu Jilai Microelectronics Co.,Ltd |
| 注册资本           | 5,224.5351 万元                          |
| 法定代表人          | 李建新                                    |
| 成立日期           | 2001 年 8 月 23 日                        |
| 整体变更为股份公司日期    | 2020 年 11 月 19 日                       |
| 公司住所和邮政编码      | 启东市汇龙镇牡丹江西路 1800 号，226200              |
| 互联网网址          | www.jilai.cn                           |
| 电子邮箱           | jlwdz@jilai.cn                         |
| 负责信息披露和投资关系的部门 | 董事会办公室                                 |
| 信息披露负责人及联系电话   | 王海霞，0513-68183606                      |

### （二）主要经营和财务数据及指标

| 项目                         | 2021 年 12 月 31 日<br>/2021 年度 | 2020 年 12 月 31 日<br>/2020 年度 | 2019 年 12 月 31 日<br>/2019 年度 |
|----------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 资产总额（万元）                   | 50,420.62                    | 32,293.37                    | 23,924.39                    |
| 归属于母公司所有者权益（万元）            | 36,348.30                    | 13,999.89                    | 9,100.01                     |
| 资产负债率（母公司）（%）              | 27.34                        | 56.08                        | 61.77                        |
| 营业收入（万元）                   | 30,104.13                    | 19,193.29                    | 13,365.00                    |
| 净利润（万元）                    | 6,996.40                     | 2,430.86                     | 127.12                       |
| 归属于母公司所有者的净利润（万元）          | 6,996.40                     | 2,430.86                     | 127.12                       |
| 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（万元） | 6,690.26                     | 2,707.66                     | 130.68                       |
| 基本每股收益（元）                  | 1.44                         | 0.59                         | 0.03                         |
| 稀释每股收益（元）                  | 1.44                         | 0.59                         | 0.03                         |
| 扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率（%）     | 25.57                        | 25.80                        | 1.45                         |
| 经营活动产生的现金流量净额（万元）          | -1,333.11                    | 645.45                       | 726.87                       |
| 现金分红（万元）                   | -                            | -                            | -                            |
| 研发投入占营业收入的比例（%）            | 4.63                         | 4.26                         | 4.77                         |

### （三）主营业务经营情况

#### 1、主营业务概况

公司专业从事功率半导体芯片及器件的研发、生产和销售，是一家以芯片设计、晶圆制造、封装测试的垂直一体化经营为主的功率半导体芯片及器件制造企业。作为具有自主研发和持续创新能力的高新技术企业，公司致力于为客户提供安全、可靠、高效的功率半导体器件和综合性的解决方案。公司目前拥有 2 条 4 英寸的芯片生产线，配套 4 条兼容 4 英寸、5 英寸、6 英寸和 8 英寸芯片封装测试的生产线，主要产品包括两大系列：功率半导体芯片和功率半导体器件。公司产品广泛应用于以家电为代表的消费电子领域、以低压电器为代表的工业领域、以手机和摄像头为代表的网络通讯和安防领域、以电动汽车为代表的汽车电子领域等。

公司是经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局认定的高新技术企业，中国半导体行业协会会员单位，南通市专精特新科技小巨人企业。公司建有经江苏省科学技术厅验收合格的江苏省新型大功率电子元器件工程技术研究中心。截至本上市保荐书签署日，公司拥有专利 40 项，其中发明专利 12 项。凭借具有市场竞争力的产品质量和配套销售服务体系，公司提供的功率半导体芯片及器件已应用至众多国内知名终端用户，以家电为代表的消费电子领域终端用户包括美的、小米等，以低压电器为代表的工业领域终端用户包括正泰电器等，以手机和摄像头为代表的网络通讯和安防领域终端用户包括中兴通讯、海康威视等，以电动汽车为代表的汽车电子领域终端客户包括比亚迪、联合汽车电子有限公司等。

报告期内，公司营业收入分别为 13,365.00 万元、19,193.29 万元和 30,104.13 万元，最近三年年均复合增长率为 50.08%，具有较高成长性。未来，公司将依托现有的技术优势和产品特点，通过不断提升研发能力，加强培养和吸引优秀技术人才等方式，进一步提升产品优势，确保公司具备可持续的市场竞争力，为业绩增长提供保障，持续提升公司在功率半导体领域的行业地位。具体而言，公司将进一步提高功率半导体器件及芯片全系列产品的研发、生产及销售能力，同时积极推进以 MOSFET、IGBT 为代表的新一代功率半导体产品的研发、生产及销售。

## 2、主要经营模式

### (1) 采购模式

公司采购部门根据生产部门每月提供的生产计划，结合现有库存情况，按月组织原材料采购。公司在长期生产经营过程中，与供应商建立了稳定的合作关系。公司在综合比较供应商产品质量、价格等因素的基础上优化采购结构，不存在依赖单一供应商的情形。

其中，IDM 模式下的产品主要是功率半导体芯片和晶闸管器件。针对 IDM 模式下的采购，公司设置采购部统一负责生产所需的原材料、设备配件等采购事项，以满足生产需求。

针对 Fabless 模式下的 ESD 器件，公司根据对下游需求市场的预判和上游原材料市场的供给情况，向符合要求的合格供应商分别采购单晶片、晶圆和封测加工服务。公司首先采购单晶片，之后由晶圆加工厂根据公司提供的单晶片与指定的设计方案生产出晶圆，晶圆生产完毕后，由晶圆厂运至公司办理入库，再将晶圆送至指定的封装测试厂进行委外加工，封装测试完成后，将产成品送至公司办理入库。

针对 MOSFET 器件，公司为下游客户提供 MOSFET 器件的综合解决方案，公司采购内容主要为晶圆以及相关的封装测试等委外加工服务。公司根据市场情况，计算相匹配的采购需求，并综合考虑生产周期、生产排期等因素制定采购计划，依据采购计划向晶圆厂下达采购订单，晶圆生产完毕后，由晶圆厂运至公司办理入库，再将晶圆送至指定的封装测试厂进行委外加工，封装测试完成后，将产成品送至公司办理入库。

### (2) 生产模式

公司以市场需求为导向，形成了满足客户需求的多品种、多批次的柔性生产组织模式。报告期内，公司主要采用“以销定产”的生产模式，根据客户提供的产品规格、质量要求和供货时间组织所需产品的生产。同时，公司结合硅片等主要原材料供应商的供货情况、主要生产设备的产能利用率情况、行业市场的供需关系变化情况，预测客户未来 3 个月内的合理需求，对下一步生产进行合理安排。公司生产过程中的部分环节和工艺采取委托加工模式，委托加工内容包括芯片代

工、封测服务等。

### （3）销售模式

公司采用直销和经销相结合的销售模式。其中功率半导体芯片采用以直销为主的销售模式，功率半导体器件采用经销和直销相结合的销售模式。

经销模式属于半导体行业普遍采用的销售模式。公司采用经销模式，符合行业惯例，是公司长期生产经营过程中积累的成功经验。为了规范经销商选取标准及日常管理等事项，公司建立了经销商管理制度，对经销商的选择标准、日常管理、货款结算和支付、订货、供货及退换货、经销商市场规范与管理等进行了规定，相关内部控制健全。

公司对经销商的准入条件包括：具有独立法人资格，拥有较强的资金实力、完善的经营管理组织、良好的商业信誉及资信状况；经销商经销发行人相关产品的主体资格及资信能力，在一定区域内具有较完备的销售系统，主要负责人和核心销售人员具有丰富的行业经验、良好的客户关系，具备较强的市场开发、产品推广和客户维护能力；经销商具备一定的技术实力，能够协助公司进行产品推广，为下游客户解决产品应用方面的技术问题；和公司无关联关系。

公司对经销商采用买断式销售，收入确认符合企业会计准则的规定，经销商主要负责：（1）利用本地优势，快速响应客户需求，为终端客户提供包括物流运输、技术支持等服务；（2）为公司持续开发终端客户，及时传递市场供需情况。公司积极发展经销商，通过与优秀的经销商建立合作关系，从而快速铺开并占领市场。

公司向经销商销售货物的定价按照公司对客户管理的统一规定，结合购买量等因素合理确定。公司产品采用自己推广的方式，经销商不承担推广、营销费用。货物送至经销商仓库，由经销商根据下游需求配送至下游客户，少量货物送至经销商指定的下游客户地址，运输费用均由公司承担。经销商向下游客户销售均为自主定价，公司不能够约束经销商向下游客户销售的价格。公司通过经销商模式实现的销售毛利率和直销模式实现的毛利率存在差异，主要系经销商采购量较大等原因，具有商业合理性；公司在直销与经销模式下与客户签订的合同在发货、签收、对账、信用期、收款、退换货等条款不存在差异；对经销商应收账款的增

加与公司业务发展相匹配，不存在异常。公司根据经销商管理制度对经销商进行考核，不存在返利或补贴等政策。公司不存在多级经销的情形，在同一城市存在多个经销商系根据当地市场情况和经销商所掌握的客户资源所做出的合理安排。公司不限定经销商下游客户区域，不存在公司指定经销商在相关区域销售公司产品的限定。

直销模式主要面向的客户为封装测试厂商及下游品牌商。对于封装测试厂商，直销模式可以通过采购公司的芯片并完成封装测试形成器件快速推向终端客户；对于下游品牌商，直销模式可以直接向公司采购元器件，并得到来自公司的直接供货、产品质量和技术服务等方面的保障。

#### （4）研发模式

公司围绕自身核心业务，以未来市场和客户需求为导向，建立并有效执行研发活动方面的内控制度，设置研发中心，建立并持续扩充专职化研发团队。公司将科研成果产业化作为研发重点，通过科学高效的研发管理模式，协调公司各职能部门共同完成研发工作。

公司设立的江苏省新型大功率电子元器件工程技术研究中心系经江苏省科学技术厅验收合格的企业类省级工程技术研究中心，主要负责公司晶闸管器件的研发和技术更新。报告期内，公司分别成立无锡吉莱和成都吉莱芯两家全资子公司，无锡吉莱承担 MOSFET 的研发和销售等工作，成都吉莱芯承担保护器件研发和销售等工作。

公司研发活动按照如下流程开展：

##### 1) 计划和项目确立

根据国家产业政策和市场调研情况，制定公司发展方向和经营计划，结合市场需求和客户需要，确定需开发的产品；研发部门在此分析基础上提出产品方案，并完成可行性分析，主要包括开发进度要求、技术要求、品质要求、项目预算、人员预算等方面的分析。

##### 2) 设计和开发

根据符合市场需求的产品信息、法律法规要求，参照类似产品的开发经验进



行产品设计、封装设计，设计出整套的产品设计规范，主要包括对产品结构、关键原材料参数等进行设计，之后进一步细分项目目标和技术参数，并进行研发任务拆解，研发部门和各职能部门明确各自任务和目标并分工合作。

### 3) 测试和反馈

在此阶段研发部门对工程样件进行检验、试验，出具产品参数表及试验报告。在完成样品的系统级和应用级验证后，测试产品性能和外观尺寸是否满足产品立项时确定的设计目标，并根据测试结果不断优化设计方案和工艺方案。

### 4) 产品试制

研发部门在品质、生产等相关部门的配合下，依据评审确定的设计和开发方案进行打样，样品质量及性能由品质部负责检验和认定。如样品通过检验并经客户验证合格，则召开项目评审会，对样品的性能参数予以全面评估，如评估认定样品的性能参数通过项目验收，则进入小批量试生产阶段。

### 5) 小批量试生产

产品试制通过后，进入小批量试生产环节。研发部门指定具体研发人员全程跟踪小批量试生产的作业状况和产品品质，如小批量试生产产品符合相关要求，研发部门提交批量投产申请，批量投产申请获得批准后，研发部门将设计和开发成果移交生产部门进行大批量生产，项目研发工作完成。

## **(5) 采用目前经营模式的原因、影响经营模式的关键因素、经营模式和影响因素在报告期内的变化情况及未来变化趋势**

公司目前采用的经营模式，是在遵循相关法律法规的基础上，在相关主管部门制定的业务规范的指导下，依据行业惯例、客户需求、多年来业务经验等制订和执行的，符合公司业务发展的需要。

报告期内，公司的经营模式和影响因素均未发生重大变化。同时在可预见的将来，公司的经营模式及其影响因素亦不会发生重大变化。

## **(四) 核心技术**

### **1、公司的核心技术及技术来源**

公司自成立至今一直致力于功率半导体器件及芯片的研发工作，形成了公司

的主要技术优势。围绕半导体功率器件、半导体防护器件系列产品，公司拥有的核心技术具体情况如下：

| 序号 | 核心技术优势              | 技术先进性及具体表象                                                                                                                                                                                      | 专利号              | 专利名称                        | 类别   | 取得方式 | 对应产品         |
|----|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------|------|------|--------------|
| 1  | 多膜层复合钝化结构与制造        | 利用 LPCVD 工艺在芯片表面依次淀积多层钝化薄膜（ $\alpha$ -多晶硅层、半绝缘多晶硅薄膜、低温热氧化层、高温 Si <sub>3</sub> N <sub>4</sub> 薄膜、负电荷性玻璃钝化层和低温热氧化层），改善台面大功率半导体器件的结表面钝化性能，减小器件的漏电流，提高器件的高温工作稳定性和可靠性，提高器件的工作结温，大幅提高生产线产品良率。         | ZL201310681860.1 | 一种台面大功率半导体器件多层复合膜钝化结构及其制备工艺 | 发明专利 | 原始取得 | TVS, TSS     |
|    |                     |                                                                                                                                                                                                 | ZL201621300138.4 | 一种大功率抗震动方片 TVS 芯片           | 实用新型 | 原始取得 | TVS          |
| 2  | 高压低损耗双向触发器件及其制作关键技术 | 基于高电阻率的薄片单晶材料，有利于制造较低的维持电压，采用高效的开管镓扩散工艺满足双向对称的高击穿电压、高温工作参数稳定的需求，引入优化的阴极短路技术获得低转折电流及维持电流。从而使得高压双向触发器件具有双向对称的负阻特性以及高温工作的稳定性，且导通损耗较低，维持电压较低，高速，低功耗的优点。                                             | ZL201310682148.3 | 一种高压双向触发器件及其制作方法            | 发明专利 | 原始取得 | TSS, ESD     |
|    |                     |                                                                                                                                                                                                 | ZL201320822983.8 | 一种新型高压双向触发器件                | 实用新型 | 原始取得 | TSS, ESD     |
| 3  | 阳极短路新结构及其关键技术       | 在阳极短路的新结构中，增加由单一 PN 结承受浪涌冲击改为 PN 结并联三极管组成泄放通路的，在大电流的浪涌冲击时，三极管导通，产生电导调制效应。此结构可以提高单位面积下的最大通流能力，并且由于三极管在大注入效应下的特性，产品获得更低的钳位电压值，有利于被保护电路不被损坏。                                                       | ZL201721380877.3 | 一种单向浪涌增强型的瞬态电压抑制二极管         | 实用新型 | 原始取得 | TVS, ESD     |
| 4  | 多路可编程集成新结构          | 基于晶闸管 PNP 结构和原理，增加了对正向浪涌起钳位作用的正向保护二极管和起触发作用的门控三极管，使得门极电位可以在一定范围内调节，从而对保护电压进行硬件编程（编程范围对地-10~-75V），满足不同电压系统的保护需求。通过优化结构单元的版图布局以及合理的 PN 结隔离技术，获得超小芯片尺寸下的多路结构。                                      | ZL201721380947.5 | 一种具有三路保护的晶闸管浪涌抑制器           | 实用新型 | 原始取得 | 集成 TSS 61089 |
| 5  | 分段式触发降容集成新结构        | 基于特有的 SCR+二极管的融合集成新结构，在基区 PN 结边界设置特定图形的 P+触发区，通过 P+触发区图形及位置的设置可以实现 P 阱的基区电阻、折回电压 VBO、折回电流 IBO 的调节，在实现参数及泄放能力情况下，可以有效地降低电容达 35%以上；在实现相同泄放能力情况下，分段式触发降容集成新结构比常规的集成结构芯片面积减小 25%以上，同时避免了器件间寄生效应的发生。 | ZL202021225257.4 | 一种低压 ESD 保护器件               | 实用新型 | 原始取得 | ESD          |
|    |                     |                                                                                                                                                                                                 | ZL202021225167.5 | 超低压触发器件                     | 实用新型 | 原始取得 | ESD          |
|    |                     |                                                                                                                                                                                                 | ZL201921081651.2 | 超低残压的双向 ESD 保护器件            | 实用新型 | 原始取得 | ESD          |

| 序号 | 核心技术优势              | 技术先进性及具体表象                                                                                                                                   | 专利号              | 专利名称                    | 类别   | 取得方式 | 对应产品 |
|----|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|------|------|------|
| 6  | 多重泄放通路集成新结构         | 通过在 SCR+PN 结的集成新结构中,增加由 PN 结或者 BJT 组成的辅助泄放通道,在小电流时,通过此辅助泄放通道提前让 SCR 导通。在大电流时,通过此辅助泄放通道分流部分能量。此结构可在增加较小面积的情况下,通过集成辅助泄放通路有效实现超低电压的多重泄放通路集成新结构。 | ZL202020649583.1 | 一种低压低电容单向 ESD 保护器件      | 实用新型 | 原始取得 | ESD  |
|    |                     |                                                                                                                                              | ZL201920850628.9 | 一种基于 SCR 结构的新型 ESD 保护器件 | 实用新型 | 原始取得 | ESD  |
| 7  | 体内触发极低电容新结构         | 在集成 ESD 的 TVS 结构的 PN 结体内,内置体内触发的高掺杂区已实现极地电容,并且此内置触发结构有助于泄放电流均流,防止电流泄放时的表面过热失效。在不增加芯片面积的情况下可有效提高泄放能力 10%,降低电容 40%左右。                          | ZL202020652470.7 | 一种低残压低电容单向 ESD 保护器件     | 实用新型 | 原始取得 | ESD  |
|    |                     |                                                                                                                                              | ZL201921082012.8 | 一种低电容的双向 ESD 保护器件       | 实用新型 | 原始取得 | ESD  |
| 8  | 晶闸管开关速度提升技术         | 穿通隔离墙扩散与 P1 区同步进行,减少长基区宽度,提高晶闸管开关速度,同时缩短制造流程,降低制造成本                                                                                          | ZL201010212303.1 | 一种提高开关速度的单向可控硅结构及其生产方法  | 发明专利 | 原始取得 | 晶闸管  |
|    |                     |                                                                                                                                              | ZL201010212163.8 | 一种消除穿通光刻针孔危害的可控硅结构生产方法  | 发明专利 | 原始取得 |      |
| 9  | 平面工艺结构的高压晶闸管设计制造技术  | 采用分压环、场板横向结构设计、以及纵向铝注入穿通隔离墙、多层钝化膜制造工艺降低高压晶闸管高温漏电,提高可靠性。                                                                                      | ZL201721380929.7 | 一种高压平面闸流管器件             | 实用新型 | 原始取得 | 晶闸管  |
| 10 | 高压、低漏电晶闸管终端结构形成技术   | 基于衬底为半绝缘 SIPOS 膜层上,采用优化的电泳液配比及工艺技术,形成均匀、致密、透明的玻璃膜,使得器件具有击穿耐压高、高温漏电小,可靠性高特征。                                                                  | ZL202022811526.1 | 一种新型台面结构芯片              | 实用新型 | 原始取得 | 晶闸管  |
|    |                     |                                                                                                                                              | ZL201310682429.9 | 一种提高正向耐压的可控硅台面结构及其制造工艺  | 发明专利 | 原始取得 |      |
| 11 | 提高电流上升率的晶闸管芯片设计制造技术 | 在阴极区和门极区之间设置隔离槽,槽内填充有玻璃层钝化保护,提高晶闸管 di/dt 能力,防止开通过程中靠近门极附近阴极区域电流集中烧毁                                                                          | ZL201210248864.6 | 一种改进的可控硅结构及其生产工艺        | 发明专利 | 原始取得 | 晶闸管  |
|    |                     |                                                                                                                                              | ZL201210248841.5 | 一种可控硅的生产工艺              | 发明专利 | 原始取得 |      |

## 2、发行人保持技术不断创新的机制、技术储备及技术创新的安排

半导体行业技术升级较快,为保持技术和产品的不断创新,满足客户需求,提升核心竞争力,公司采取了针对性措施,逐渐形成了在功率半导体芯片及器件领域较强的研发与技术优势。

### (1) 研发创新为本,完善激励机制

公司通过引进先进的研发分析设备和检测仪器,招聘和培养研发人员,增强公司的技术研发实力,不断提升公司的研发技术平台。公司积极推进研发组织建设,通过理顺研发管理流程,细化研发过程管控,强化研发成果转化机制,持续

优化技术资源配置，不断完善公司的技术创新管理平台，技术的持续创新是公司在半导体行业保持领先地位的根本保证。公司始终奉行技术创新为本的发展理念，高度重视基础科学的研究和产品工艺的创新，大力投入研发资源，设立多层次研发机构，对技术创新实施针对性奖励。

## **（2）建立健全人才管理体系，加强研发队伍建设**

公司通过建立管理与技术双重体系，为研发技术人员提供完善的职业发展通道。公司高度重视人才引入和培养，一方面通过校园招聘、社会招聘不断引进专业人才，不断壮大研发队伍；另一方面，公司针对不同级别人员制定了完善的人才培养计划，并根据员工业务需要举行定期或不定期的教育及培训，不断提高员工专业素质，为公司发展提供人才保障。公司充分发挥核心技术人员的技术带头人作用，在带领技术团队开展研发项目工作的同时，肩负培养和发展科研团队的职责，在项目的实践与创新过程中指导、提高技术人员的研发水平，为公司技术创新与发展做出贡献。

## **（3）以客户需求为导向，加强技术合作交流**

公司坚持以客户需求为导向，深入了解行业及客户需求动态，并根据市场调研和客户需求形成新产品开发计划，充分利用与客户同步开发的契机，推动公司的创新活动，努力为客户提供一揽子的解决方案。公司围绕行业新技术发展方向，优化研发信息与市场信息反馈机制，通过对行业内关键性、先进性、前瞻性的技术研究，不断提升公司的核心竞争能力。公司以创新为动力，加强与国内知名高等院校及科研院所的技术合作交流，加快技术研发速度，把握最新前沿技术，大力研发具有自主知识产权的核心技术。

## **（五）研发水平**

### **1、发行人研发人员情况**

公司坚持以人为本的人才理念，建立了适应市场化需求的自主创新机制和优秀人才引进计划，培养一批在功率半导体器件领域内的研发力量，具有较强的自主创新能力。截至 2021 年 12 月 31 日，公司从事技术和研发工作的相关人员 53 人，占员工总人数的 10.17%。其中，核心技术人员共 4 人，包括许志峰、张鹏、宋文龙、杨珏琳。

## 2、发行人核心技术人员情况

目前公司的核心技术人员为许志峰、张鹏、宋文龙、杨珏琳，其具体情况如下：

| 姓名  | 学历背景及专业资质                      | 重要科研成果、及获得奖项情况                                                                                                                                                        | 对发行人研发具体贡献                                                                                 |
|-----|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 许志峰 | 华中工学院（现华中科技大学）固体电子专业学士学位，高级工程师 | 公司董事，从事多种功率半导体芯片设计开发及产业化工作三十余年，先后参与国内 3 条功率半导体晶圆生产线建线、产品与工艺研发和量产化运行的技术工作；2001 年主持开发的“SBDIA 系列硅肖特基势垒二极管”获江苏省优秀新产品（金牛奖）；主持研发的新型功率半导体器件 VDMOS 获得无锡市科技进步奖三等奖。获实用新型专利 9 项  | 主持晶闸管产品设计、制造工艺技术持续创新，使得公司成为晶闸管方形芯片国产化主力供应厂商之一；负责公司新产品的开发、产业化及量产产品的技术改进工作，为公司业绩持续稳定增长提供技术支撑 |
| 张鹏  | 电子科技大学微电子与固体电子学专业硕士学位，工程师      | 公司副总经理，具有多年功率半导体器件和集成器件的研发工作经验，2013 年加入公司后，研发出了一种单向具有高浪涌能力的高压保护器件；主导开发出了 BTM 三种结构为基础的防护器件；2017 年《高速低功耗 BVTD 双向高压触发器件》获南通市科学进步二等奖和启东市科学进步一等奖，获发明专利 3 项，实用新型专利 23 项     | 主要负责 4 寸线上保护器件产品研制和 6、8 寸线上保护器件产品设计开发，公司保护器件新产品的开发、产业化及量产产品的技术改进工作                         |
| 宋文龙 | 电子科技大学微电子与固体电子学专业硕士学位，工程师      | 公司研发工程师，具有多年半导体分立器件研发工作经验，2018 年加入公司后，主要参与“一种集成的低电容 ESD 保护器件及其制备方法”、“一种低电容的双向 ESD 保护器件”、“一种低残压低电容单向 ESD 保护器件及其制作方法”、“一种低压低电容单向 ESD 保护器件及其制作方法”等多个项目的研发工作，获实用新型专利 13 项 | 主要参与高速 ESD 保护器件等产品的开发工作，建立全系列 ESD 产品库，推进产品的量产以及技术改进工作                                      |
| 杨珏琳 | 电子科技大学集成电路工程专业硕士学位，工程师         | 公司研发工程师，具有多年半导体分立器件研发工作经验，2019 年加入公司后，主要参与“一种基于 SCR 结构的新型 ESD 保护器件”、“超低残压的双向 ESD 保护器件”、“一种电压可调的双向 ESD 保护器件”、“超低压触发器件及其制作方法”等多个项目的研发工作，获实用新型专利 12 项                    | 主要参与高速低残压 ESD 保护器件等产品的开发工作，推进高速集成 ESD 产品的研发、量产以及技术改进工作                                     |

公司与上述核心技术人员均签署了劳动合同、保密协议和竞业禁止协议，对其在保密义务、知识产权及离职后的竞业情况作出了严格的约定，以保护公司的合法权益。

### （六）发行人存在的主要风险

针对发行人在生产经营与业务发展中所面临的风险，本保荐机构已敦促并会

同发行人在其《招股说明书》中披露了发行人可能存在的风险因素，主要如下：

## **1、创新风险**

公司自设立至今一贯重视研发与创新，不断丰富产品种类，提升产品性能。未来公司将响应国家半导体自主可控的战略及市场需求，持续拓展分立器件产品线，增加公司在高端 MOSFET、IGBT、高端保护器件等高技术、高附加值领域的研发投入，并拓展开发在 5G、汽车电子、新能源、工业控制等不同应用领域的产品应用。如果公司新业务、新产品的推出受到各种不确定性因素影响在产品品质、成本控制等各方面未能达到预期成效，或无法获得市场认可，存在创新失败从而对公司的业务发展造成不利影响的风险。

## **2、技术风险**

### **(1) 技术更新及新产品开发风险**

功率半导体行业在半导体材料、晶圆制造技术、器件封装技术等方面处于不断发展中，终端应用领域的发展要求功率半导体器件具有较高的电气安全性、电气保护功能稳定性和灵敏度，以及大电流、高电压和高温承载性等性能，对公司产品性能要求较高，未来公司需要根据功率半导体行业的发展趋势和客户的差异化需求不断进行技术升级和创新。如果公司不能适时进行技术革新，未能及时改进产品质量、提升产品性能和稳定性，将对公司未来经营业绩产生不利影响。

### **(2) 关键技术人员流失及核心技术泄密风险**

功率半导体芯片及器件的研发及生产需要结合材料科学技术、微电子工程技术、物理电路等多学科、多领域技术，对研发人员的综合素质要求比较高。截至 2021 年 12 月 31 日，公司从事技术与研发工作的相关人员合计 53 人，占公司员工总数的 10.17%。一方面如果公司关键技术人员流失，则可能会削弱公司的核心竞争力及市场影响力；另一方面，如果公司无法有效的持续引入优秀技术人才，将会对公司的技术创新、产品研发、市场占有率提升等产生不利影响。此外，若公司在经营过程中因核心技术信息保护不善、核心技术人员流失等原因导致核心技术泄密，将对公司研发工作与业务发展产生不利影响。

### **(3) 新产品研发失败的风险**



公司所处的功率半导体领域革新较快,公司需要持续研发以保持产品创新和市场竞争能力。同时,功率半导体器件和芯片在消费电子、工业控制、汽车电子、通讯、安防等多领域拥有广泛的应用场景,公司研发团队正在积极投入对 MOSFET 和高端保护器件芯片的研究。如果公司不能成功突破相关技术瓶颈或无法开拓有效的新产品销售渠道,公司将面临新产品研发失败的风险。

报告期内,公司研发费用分别为 637.80 万元、816.94 万元和 1,393.84 万元,新产品开发失败可能导致上述已投入的研发费用无法产生预计效益,并对公司未来的盈利能力产生不利影响。

### 3、经营风险

#### (1) 行业周期及宏观经济波动的风险

功率半导体行业具有一定的周期性,下游应用领域与宏观经济的整体发展密切相关。2018 年四季度起,功率半导体行业进入下行周期,2019 年行业整体处于低谷。2020 年一季度以来,受新冠疫情等多重因素影响,功率半导体行业整体处于高景气度的状态,产业链内企业业绩普遍有所增长。如果未来宏观经济波动较大或者功率半导体行业整体进入低迷下行状态,功率半导体行业的供需关系可能发生重大变化,从而影响公司的收入和盈利水平。

#### (2) 市场竞争加剧的风险

功率半导体产品应用范围广泛,受国家政策引导和行业整体需求改善等因素影响,国内功率半导体企业积极响应进口替代,国内从事功率半导体业务的企业日益增多,正积极进行技术升级并扩大生产规模。如果同行业竞争对手开发出与公司具有同等竞争力的产品,公司在产品技术升级、产能、品质管控等方面不能适应市场变化,可能在激烈的市场竞争中处于不利地位,从而影响公司的市场占有率和盈利能力。

#### (3) 原材料价格波动风险

公司生产经营所需的主要原材料为引线框架、硅片、塑封料及化学试剂等。报告期内,公司直接材料成本占当期主营业务成本的比例分别为 50.15%、52.44% 和 58.32%。未来如果原材料价格持续上涨或者与主要供应商的合作发生重大不利变化,而公司未能及时采取有效措施,公司将面临因原材料价格上升而引发的

盈利水平下降的风险。

#### **(4) 产品质量风险**

功率半导体器件是电力电子产品的基础之一，也是构成电力电子变化装置的核心器件之一，主要用于整流、稳压、开关、电路保护等，具有应用范围广、用量大的特点，因此功率半导体器件具有较高的安全性、稳定性、耐高温等性能要求。若未来公司质量控制环节出现疏漏，则可能造成产品质量风险，损害公司形象，影响公司业绩。

#### **(5) 产品结构单一风险**

公司专业从事功率半导体芯片及器件的研发、生产和销售，下游市场集中在消费电子、工业控制、通讯、安防、汽车电子等领域。凭借较强的市场竞争力，公司产品在晶闸管市场具有较强的市场影响力。报告期内，晶闸管系列产品占主营业务收入的比例在 60%以上，存在对晶闸管产品依赖较大的风险。若未来行业竞争加剧或产品更新换代导致产品价格下降，或下游市场环节发生重大不利变化，则公司将面临较大的业绩波动风险。

#### **(6) 限电限产措施可能影响公司正常生产经营的风险**

2021 年 8 月和 9 月，国家发改委陆续发布《2021 年上半年各地区能耗双控目标完成情况晴雨表》和《完善能源消费强度和总量双控制度方案》，指导各地区各部门深入推进节能降耗工作，推动高质量发展和助力实现碳达峰、碳中和目标。在上述政策目标指导下，各地相继出台限电限产举措，包括江苏、广东、云南、山东、浙江、河南等省份。公司生产主体位于江苏省南通市，所处地区供电局从 2021 年 9 月下旬至 2021 年 10 月上旬实施限电、限产措施，限电限产措施一定程度上导致公司排产难度提升，生产效率下降，生产成本上升。如未来限电限产举措进一步收紧，公司的正常生产经营将受到不利影响，主要包括：在销售端可能导致公司不能按照订单要求及时交付产品、下游客户因自身限电推迟或减少订单，在生产端可能引起上游供应商限产导致主要原料不能及时供应、原料价格上涨以及公司生产设施闲置发生减值等风险。

#### **(7) 新冠疫情导致公司经营业绩下滑风险**

2020 年新冠肺炎疫情的爆发，对全球经济运行、企业生产经营活动造成不



利影响，虽然我国新冠疫情整体应对良好，但随着病毒的变异及传播速度加快，国内疫情较为严重区域的物流及上下游厂商的生产经营均受到不利影响，在一定程度上也影响了公司的经营情况。2022 年上半年因全国疫情反复，公司受到上游供应短缺、下游客户需求降低的不利影响。虽然疫情对公司未产生重大持续性不利影响，上游采购供应和下游客户需求也逐步恢复正常，但未来如果疫情在局部地区出现反弹，仍将对公司的经营业绩产生一定不利影响。

#### **4、内控风险**

##### **(1) 实际控制人不当控制风险**

截至本上市保荐书签署日，公司实际控制人为李建新、李大威父子，二人合计控制公司 73.69%的表决权，李建新担任公司董事长、总经理，李大威担任公司董事、副总经理。本次发行后，公司实际控制人李建新、李大威的持股比例将会有所下降，但仍处于控股地位。虽然公司已按照现代企业制度完善了法人治理结构，但实际控制人仍有可能利用其控股地位，对公司的日常经营、人事、财务、投融资决策等实施不当控制，从而损害公司和中小股东的利益。

##### **(2) 管理风险**

若本次发行成功，公司的资产规模和经营规模将进一步扩大，对公司管理层的管理能力和治理能力提出了更高的要求。公司管理层在公司经营发展中已经积累了丰富的生产、销售等管理经验，但如果未来公司经营团队的决策水平、人才队伍的管理能力和组织结构的完善程度不能及时适应公司业绩规模的扩张，将对公司未来的经营业绩、盈利能力、市场竞争力产生不利影响。

#### **5、财务风险**

##### **(1) 业绩增速放缓及下滑风险**

报告期各期，公司营业收入分别为 13,365.00 万元、19,193.29 万元和 30,104.13 万元，营业收入年均复合增长率达 50.08%，净利润分别为 127.12 万元、2,430.86 万元和 6,996.40 万元。报告期内，公司业绩增长迅速，但是功率半导体行业受国家政策、宏观经济环境、终端市场需求波动影响较大，近年来市场竞争较为激烈，市场需求变化明显，如果公司未来不能持续保持竞争优势以满足市场和客户的需求，乃至未来功率半导体行业扩张过度导致供需关系发生重大不利变化，功率半

导体行业产品售价、销量可能出现下降；同时，公司最近两年发展迅速，设备投资及产能规模增长较快，但不排除未来市场需求下降导致产能过剩，进而面临业绩增速放缓及下滑的风险。

## **（2）毛利率下降的风险**

报告期各期，公司主营业务收入毛利率分别为 21.47%、31.59%和 38.98%。受行业景气度提高、公司生产规模扩大及效率提升、产品结构优化等多重因素影响，公司毛利率水平不断提升。为了确保市场竞争力，公司必须根据市场需求不断进行技术迭代升级和创新。未来如果市场供需关系变化，市场需求量下降，直接材料价格上升，用工成本增加，或竞争对手大幅扩产、采取降价策略等导致产品供求波动、产品结构向低毛利率产品倾斜，可能导致公司产品销售价格下降、成本上升，从而导致公司毛利率出现下降的风险。

## **（3）存货跌价风险**

报告期各期末，公司存货账面价值分别为 3,435.17 万元、4,179.80 万元和 7,413.62 万元，占流动资产的比例分别为 30.88%、26.96%和 30.55%，金额及占比较大，且可能随着公司经营规模的扩大而进一步增加。公司每年根据存货的可变现净值低于成本的金额计提相应的跌价准备，未来如果公司市场供需关系发生重大不利变化、产品市场价格及毛利率下降、原材料价格大幅上升、技术迭代等导致产品需求下降或被淘汰，公司可能出现存货滞销、存货跌价损失等风险，影响公司存货的周转经营效率，从而对公司经营成果产生不利影响。

## **（4）应收款项无法收回的风险**

报告期各期末，公司应收账款余额分别为 5,236.38 万元、7,327.36 万元和 8,079.95 万元，占当期营业收入的比重分别为 39.18%、38.18%和 26.84%。未来，随着公司业务规模的不断扩张及营业收入的不断增长，应收账款金额将相应增加。如果出现应收账款无法按期回款甚至无法收回的情况，公司可能会面临流动资金短缺或出现坏账损失，对公司经营产生不利影响。

## **（5）无法继续享受税收优惠政策的风险**

公司于 2018 年 11 月和 2021 年 11 月分别通过高新技术企业认定，自 2018 年至 2020 年、2021 年至 2023 年享受 15%的企业所得税优惠政策。报告期内，

公司享受的高新技术企业税收优惠金额分别为 16.90 万元、293.50 万元和 769.33 万元。若公司在未来未能继续被认定为高新技术企业或企业所得税税收优惠的法律法规发生重大变化，将会对公司经营业绩产生不利影响。

## 6、发行失败风险

根据相关法规要求，若发行人本次发行时提供有效报价的投资者或网下申购的投资者数量不足法律规定要求，本次发行应当中止；若发行人中止，发行上市审核程序超过深圳交易所规定时限或者中止发行注册程序超过 3 个月仍未恢复，或者存在其他影响发行的不利情形，或导致发行失败的风险。

## 7、募集资金投资项目风险

公司本次募集资金投资项目为功率半导体器件产业化建设项目、生产线技改升级项目、研发中心建设项目和补充流动资金，项目需要一定的建设期和达产期。本次募集资金投资项目建成后，固定资产原值较发行前有较大幅度的增加，相应的固定资产折旧金额将有所增加。若项目实施过程中和项目实际完工后，市场环境、国家政策等方面出现重大不利变化，导致公司新增产能不能及时充分消化，则可能对募投项目的收益率和公司未来的盈利能力产生一定的不利影响。

## 二、本次发行概况

|                   |                                                                 |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 股票种类              | 人民币普通股（A 股）                                                     |
| 每股面值              | 人民币 1.00 元                                                      |
| 发行股数、占发行后总股本的比例   | 本次公开发行股票数量不超过 1,741.5117 万股，占本次发行后总股本的比例不低于 25%，本次发行不涉及股东公开发售股份 |
| 每股发行价格            | 【 】元/股                                                          |
| 发行人高管、员工拟参与战略配售情况 | 不适用                                                             |
| 保荐人相关子公司拟参与战略配售情况 | 不适用                                                             |
| 发行市盈率             | 【 】倍                                                            |
| 发行前每股净资产          | 【 】元/股                                                          |
| 发行后每股净资产          | 【 】元/股                                                          |
| 发行市净率             | 【 】倍                                                            |
| 发行方式              | 采用网下向询价对象申购配售及网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，或证券监管部门认可的其他发行方式             |
| 发行对象              | 符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开立创业板 A 股股票                                   |

|                |                                                               |
|----------------|---------------------------------------------------------------|
|                | 账户的符合条件的境内自然人、法人等其他投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）和中国证监会、深圳证券交易所认可的其他发行对象 |
| 承销方式           | 余额包销                                                          |
| 发行费用概算         | 【 】万元                                                         |
| 其中：承销及保荐费用     | 【 】万元                                                         |
| 审计及验资费用        | 【 】万元                                                         |
| 律师费用           | 【 】万元                                                         |
| 与本次发行相关的信息披露费用 | 【 】万元                                                         |
| 发行手续费用         | 【 】万元                                                         |

### 三、本次证券发行的保荐机构工作人员情况

#### （一）负责本次证券发行的保荐代表人姓名及其执业情况

盛凯先生，保荐代表人，律师，取得注册会计师专业阶段合格证书，北京大学法律硕士，曾任职于民生证券投资银行事业部。曾参与易尚展示（002751）非公开发行项目、兴业科技（002674）非公开发行项目、日海智能（002313）详式权益变动财务顾问项目、环国运（871725）新三板挂牌项目、汉弘集团改制辅导和 IPO 申报项目、珠海美利信新材料股份有限公司改制辅导工作、达特照明上市辅导等，具有较为丰富的投行业务知识和经验。

杨冠丽女士，保荐代表人，注册会计师，硕士研究生，毕业于上海交通大学。2018 年进入广发证券投资银行部、2019 年通过注册会计师和保荐代表人考试、2020 年加入长江保荐。从业以来，曾参与长江都市 IPO、霍普股份 IPO、标榜股份 IPO、百川股份非公开发行、万润科技并购、亚派科技辅导等工作，具有较丰富的投资银行业务知识和项目经验。

#### （二）本次证券发行的项目协办人姓名及其执业情况

本次发行项目的项目协办人为单益峰。

单益峰先生，注册会计师，管理学硕士，曾参与过亚派科技 IPO，具有扎实的资本市场理论基础与较丰富的投资银行业务经验。

#### （三）其他项目组成员姓名

项目组其他成员为：章睿、孙雨、蒋瑞光、章亦洵。

#### 四、保荐机构是否存在可能影响其公正履行保荐职责的情形的说明

本保荐机构与发行人之间不存在下列任何情形：

（一）保荐机构及其控股股东、实际控制人、重要关联方持有或者通过参加本次发行战略配售持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况。

（二）发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况。

（三）保荐机构的保荐代表人及其配偶、董事、监事、高级管理人员，持有发行人或其控股股东、实际控制人及重要关联方股份，以及在发行人或其控股股东、实际控制人及重要关联方任职的情况。

（四）保荐机构的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、实际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资等情况。

（五）保荐机构与发行人之间的其他关联关系。

#### 五、保荐机构按照有关规定应当承诺的事项

（一）本保荐机构已按照法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，对发行人及其控股股东、实际控制人进行了尽职调查、审慎核查，对本次发行项目进行了全面复核，同意推荐发行人证券发行上市，并据此出具本发行保荐书。

（二）本保荐机构已按照中国证监会以及深圳证券交易所的有关规定，对原保荐机构辅导情况进行复核，进行了充分的尽职调查，本保荐机构有充分理由确信该发行人至少符合下列要求：

- 1、符合首次公开发行股票并上市的条件和有关规定，具备持续发展能力；
- 2、与发起人、大股东之间在业务、资产、人员、机构、财务等方面相互独立，不存在同业竞争、显失公允的关联交易以及影响发行人独立运作的其他行为；
- 3、发行人治理、财务和会计制度等不存在可能妨碍持续规范运作的重大缺陷；
- 4、高管人员已掌握必备的证券市场法律、行政法规和相关知识，知悉上市

公司及其高管人员的法定义务和责任，具备足够的诚信水准和管理上市公司的能力及经验。

（三）根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的规定，本保荐机构作出如下承诺：

1、有充分理由确信发行人符合法律法规及中国证监会有关证券发行上市的相关规定；

2、有充分理由确信发行人申请文件和信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

3、有充分理由确信发行人及其董事在申请文件和信息披露资料中表达意见的依据充分合理；

4、有充分理由确信申请文件和信息披露资料与证券服务机构发表的意见不存在实质性差异；

5、保证所指定的保荐代表人及本保荐机构的相关人员已勤勉尽责，对发行人申请文件和信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查；

6、保证保荐书、与履行保荐职责有关的其他文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

7、保证对发行人提供的专业服务和出具的专业意见符合法律、行政法规、中国证监会的规定和行业规范；

8、自愿接受中国证监会依照《证券发行上市保荐业务管理办法》采取的监管措施。

（四）保荐机构及负责本次证券发行保荐工作的保荐代表人特别承诺

1、本保荐机构与发行人之间不存在其他需披露的关联关系；

2、本机构及负责本次证券发行保荐工作的保荐代表人未通过本次证券发行保荐业务谋取任何不正当利益；

3、负责本次证券发行保荐工作的保荐代表人及其配偶未以任何名义或者方式持有发行人的股份。

## 六、本次证券发行上市所履行的决策程序

（一）发行人股东大会已依法定程序作出批准本次发行的决议。

发行人已按照《公司法》、《证券法》、中国证监会以及深圳证券交易所发布的规范性文件的相关规定及其《公司章程》召开股东大会批准了本次发行。

发行人第一届董事会第七次会议审议通过了本次发行的相关决议：《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市的议案》等与本次发行上市相关的议案，并决定于 2022 年 5 月 10 日召开发行人 2022 年第一次临时股东大会。

发行人 2022 年第一次临时股东大会审议通过了本次发行的相关决议：《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市的议案》等议案。

（二）根据有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等规定，上述决议的内容合法有效。

发行方案经董事会、股东大会决议通过，其授权程序符合《公司法》第九十九条、第三十七条、第四十六条、第一百三十三条的规定，其内容符合《公司法》第一百二十六条、《证券法》第四十七条、《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》第十四条、第十五条的规定。

（三）发行人股东大会授权董事会办理本次首次公开发行人民币普通股股票的相关事宜，授权范围及程序合法有效。

（四）根据《证券法》第九条、第二十一条、第四十六条，《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》第五条、第十六条的规定，发行人本次发行尚须经深圳证券交易所发行上市审核并报经中国证券监督管理委员会履行发行注册程序。

综上所述，本保荐机构认为，发行人本次发行已获得了必要的批准和授权，履行了《公司法》《证券法》和中国证监会及深圳证券交易所规定的决策程序，决策程序合法有效。发行人本次发行上市尚需依法经深圳证券交易所审核同意并报经中国证监会履行发行注册程序。

## 七、保荐机构关于发行人本次证券发行符合上市条件的说明

本保荐机构对发行人是否符合《上市规则》规定的上市条件进行了逐项核查。经核查，本保荐机构认为发行人本次发行符合《上市规则》规定的上市条件，具体情况如下：

（一）根据《长江证券承销保荐有限公司关于江苏吉莱微电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之发行保荐书》中“八、对本次证券发行的推荐意见”，发行人符合《证券法》、《注册管理办法》规定的公开发行股票的条件，符合中国证监会规定的发行条件，符合《上市规则》第 2.1.1 条第（一）项的规定。

（二）根据发行人《营业执照》和《公司章程》，发行人截至本上市保荐书出具日已发行的股本总额为 5,224.5351 万股，不低于 3,000 万股，符合《上市规则》第 2.1.1 条第（二）项。

（三）根据发行人本次发行上市的相关方案并经核查，发行人截至本上市保荐书出具日已发行的股份总数为 5,224.5351 万股，本次申请公开发行不超过 1,741.5117 万股股票，本次发行完成后公开发行股份的比例不低于 25%，符合《上市规则》第 2.1.1 条第（三）项的规定。

（四）根据《上市规则》第 2.1.2 条，发行人选择的具体上市标准为“（一）最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于人民币 5,000 万元”。

2020 年、2021 年，公司归属于母公司股东的净利润（以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据）分别为 2,430.86 万元、6,690.26 万元，累计超过人民币 5,000 万元，符合《上市规则》第 2.1.2 条第（一）项的规定。

综上所述，本保荐机构认为，发行人本次发行上市符合《证券法》、《注册管理办法》、《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的发行、上市条件。

## 八、保荐机构对发行人持续督导工作的安排

### （一）保荐人针对发行人具体情况确定持续督导的期限、内容和重点

1、持续督导期限为在本次发行结束当年的剩余时间以及以后 3 个完整会计年度。



2、督导发行人有效执行并完善防止大股东、实际控制人、其他关联机构违规占用发行人资源的制度；

3、督导发行人有效执行并完善防止高管人员利用职务之便损害发行人利益的内控制度；

4、督导发行人有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，并对关联交易发表意见；

5、督导发行人履行信息披露的义务，审阅信息披露文件及向证监会、证交所提交的其他文件；

6、持续关注发行人募集资金的专户存储、投资项目的实施等承诺事项；

7、持续关注发行人为他人提供担保等事项，并发表意见；

8、相关法律及其它监管规则所规定约定的其他工作。

## **（二）发行人和其他中介机构配合保荐机构履行保荐职责的相关约定**

1、发行人及其董事、监事、经理和其他高级管理人员，应当依照法律、行政法规和证监会的规定，配合本保荐机构履行保荐职责并承担相应的责任；本保荐机构及保荐代表人履行保荐职责，不减轻或免除发行人及其董事、监事、经理和其他高级管理人员的责任；

2、发行人承诺向本保荐机构和证监会、证券交易所提交的与保荐工作相关的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

3、有下列情形之一的，发行人应当通知或者咨询本保荐机构，并按协议约定将相关文件送本保荐机构：

（1）变更募集资金及投资项目等承诺事项；

（2）发生关联交易、为他人担保等事项；

（3）履行信息披露义务或者向证监会、证券交易所报告有关事项；

（4）发生违法违规行为或其他重大事项。

## **（三）其他安排**

在保荐期间有针对性地为发行人提供及时有效的专项或日常财务顾问服务，

以便使其更好地符合《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定的要求。

## **九、保荐机构和保荐代表人联系方式**

保荐机构：长江证券承销保荐有限公司

保荐代表人：盛凯、杨冠丽

联系地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层

电话：021-61118978

传真：021-61118973

## **十、保荐机构认为应当说明的其他事项**

无应当说明的其他事项。

## **十一、保荐机构对本次股票上市的推荐结论**

本保荐机构认为：发行人申请其股票在创业板上市符合《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，发行人股票具备在深圳证券交易所创业板上市的条件。本保荐机构同意推荐发行人股票在深圳证券交易所创业板上市交易，并承担相关保荐责任。

（以下无正文）

(本页无正文,专用于《长江证券承销保荐有限公司关于江苏吉莱微电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的上市保荐书》之签字盖章页)

保荐代表人: 盛凯  
盛凯

杨冠丽  
杨冠丽

项目协办人: 单益峰  
单益峰

内核负责人: 杨和雄  
杨和雄

保荐业务负责人: 王承军  
王承军

法定代表人、总经理: 王承军  
王承军

保荐机构董事长: 吴勇  
吴勇

长江证券承销保荐有限公司  
2022年6月28日